بررسی رفتار ارتعاشی غیرخطی میکروتیرکهای پیزوالکتریک در برهمکنش با نانو ذرات کروی

رضا قادری (**، مهدی جهانگیری ۲، احمد حقانی ۲، سعید دانشمند ۳

چکیدہ	اطلاعات مقاله
	دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
امروزه میکروتیرکهای پیزوالکتریک بواسطه داشتن ساختاری انعطاف پذیر،	پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
حساسیت بالا بـه نیروهـای مولکـولی و اتمـی و همچنـین پاسـخدهـی بسـیار سـریع بطـور	
گســتردهای در میکروسـکوپهـای نیـروی اتمـی، اصـطکاکی و اسـکن حرارتـی مـورد	واژگان کلیدی:
توجه قرارگرفتهاند. بـا توجـه بـه جابجـایهـای کوچـک ايـن نـوع ميکـروتيـرکها،تحليـل	ارتعاش غيرخطي،
ارتعاشی کامل و مطالعه چگونگی رفتـار آنهـا مـیتوانـد، نقشـی کلیـدی در دقـت انـدازه-	میکروتیرک پیزوالکتریک،
گیـرىهـاى آنهـا و همچنـين طراحـي بهينـهشـان داشـته باشـد. در مـد غيـرتماسـي	نانو ذره،
میکروسیکوپ نیروی اتمی، نیروی غیرخطی واندروالسی باعث غیرخطی شدن	المان محدود،
حرکت ارتعاشبی میکروتیرک می،شود. به منظور حل معادله دیفرانسیل غیرخطبی	تحليل حساسيت.
حرکـت در ایــن مقالــه از روش عــددی (رانـچ کوتــا و المــان محــدود) و تحلیلــی (چنــد	
مقیاسی) استفاده میشود. بهرهگیری از روشهای حل مختلف، امکان مقایسه آنها	
در حـل معادلــه دیفرانســیل حرکـت در شــرایط مختلـف را مهیــا مــیکنــد. بــه منظـور	
مطالعـه علممي چگلونگي تـاثير ضرايب نيرويمي بـر پارامترهـاي اصلي حركـت ارتعاشمي	
تحلیل حساسیت ضروری میباشد. بـه ایـن منظـور بـه کمـک روش Sobol کـه مبتنـی	
بر واریانس دادههای خروجـی اسـت، تحلیـل حساسـیت انجـام مـی.پـذیرد. نتـایج شـبیه-	
سازی نشـان مــیدهـد کــه مـدل تيـر ناپيوسـته و همچنــين روش المـان محـدود از دقـت	
قابل قبولی در محاسبه فرکانس طبیعی و دامنه تشدید این نوع میکرو-	
تیرکبرخـوردار اسـت. بـا نزدیـک شـدن میکـروتیـرک بـه سـطح نمونـه و شـدت گـرفتن	
نیـروی غیـرخطـی بـرهمکـنش نتـایج روش چنـد مقیاسـی از نتـایج دو روش حـل دیگـر	
فاصله میگیرد. ایـن موضـوع بیـانگر کـاهش دقـت روش چنـد مقیاسـی بـا شـدت گـرفتن	
غیرخطی شدن سیستم میباشد. نتایج تحلیـل حساسـیت نیـز مشـخص میکننـد کـه	
مداول حرکت ارتعاشمی میکرو تیرک مناسب ترین مد جهت توپوگرافی سطح و	
نانوذره میباشد.	

۱–مقدمه

از آنجایی که میکرو تیر کها را می توان برای توسعه فناوری میکرو سنسورها مورد استفادهقرارداد، امروزه این نوع

تجهیزات از محبوبیت بالایی در بسیاری از کاربردهای علمی برخوردار شدهاند. از میکروتیرکها در کاربردهایی چون بیولوژی[۳–۱]،شیمی [۶–۴]،فیزیک[۸–۷] و رئولوژی[۹]

^{*.} پست الكترونيك نويسنده مسئول: Reza.Ghaderi@iaushk.ac.ir

۱. استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد، ایران

۲. مربی، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

۳. استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

می توان بهره گرفت. در واقع وظیفه اصلی میکروتیر کها تبدیل تغییر شکلهای فیزیکی به سیگنالهای قابل تشخیص میباشد. میکروتیر کها قادر به تشخیص تغییرات نیروی اعمالی با دقت پیکونیوتن و همچنین جابجایی با دقتی در حد آنگستروم می باشند[۱۰]. این تشخیصها با سرعتی بسیار بالا در حد میلی ثانیه انجام می شود. از دیگر مزایای میکروتیر کها می توان به قابلیت اطمینان بالا، امکان اتصال به مدارهای مجتمع الکتریکی و همچنین سردو گرم شدن در حد چند میکروثانیه اشاره کرد.

میکروتیرکهای پیزومحرک نسل جدیدی از تیرکها هستند که با توجه به قابلیتهای بالایشان امروزه مورد توجه خاصی قرار گرفتهاند. در این نوع میکروتیرکها بدنه اصلی توسط یک لایه پیزوالکتریک پوشیده شده است. با اتصال ولتاژ مناسب به این لایه میتوان حرکت ارتعاشی مورد نیاز میکروتیرک را تامین کرد. معمولاً برای افزایش مورد نیاز میکروتیرک قسمت نوک باریکتر از بدنه اصلی ساخته میشود. بنابراین این نوع میکروتیرکها به دلیل داشتن لایه پیزوالکتریک تکهای و همچنین قسمت نوک ازناپیوستگی هندسی برخوردار میباشند که لازم است این ناپیوستگیهای هندسی در مدلسازی ارتعاشی مورد توجه قرار بگیرند.

با توجه به کاربردهای وسیع میکروتیر کهای پیزوالکتریک آنالیز ارتعاشی کامل و مطالعه چگونگی رفتار ارتعاشی آنها میتواند نقشی کلیدی در داشتن درک بهتری از نحوه عملکرد، افزایش دقت اندازه گیری و همچنین طراحی و ساخت بهینه آنها داشته باشد.

تاکنون مطالعات زیادی بر روی رفتار ارتعاشی میکروتیرک-های معمولی (بدون لایه پیزوالکتریک) در نزدیکی سطح نمونه و همچنین نانو ذرات انجام شده است [۱۲–۱۱]. به کمک این مطالعات چگونگی رفتار ارتعاشی این نوع میکرو-تیرکها رادر برهمکنش با سطح نمونه و نانو ذرات مشخص شده است. اما مطالعات انجام شده بر روی نحوه مدل سازی حرکت ارتعاشی میکروتیرکهای پیزوالکتریک و همچنین

"Multiple Time Scale

چگونگی رفتار ارتعاشی آنها بسیاراندک میباشد. Wolf ووGottlieb با استفاده از روش تغییرات جزئی حرکت ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک را در نزدیکی سطح نمونه مدلسازی کردند[۱۳]. آنها مدلسازی را بر روی میکروتیرک در حالت سادهشده با لایه پیزوالکتریک سراسری و بدون ناپیوستگی هندسی انجام دادند.

Fung و Huang نيز با استفاده از روش المان محدود ارتعاش میکروتیرک پیزوالکتریک ساده شده را در نزدیکی سطح نمونه مورد مطالعه قرار دادند [۱۴]. مطالعه چگونگی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک با وجود ناپیوستگیهای هندسی در فاصله دور از سطح نمونه و در کاربری غیر از میکروسکوپ نیروی اتمی توسط محمودی و همكارانش [16] و همچنين صالحي خجين و همكارانش [۱۶] انجام شده است. محمودی و همکارانش حرکت ارتعاشی این نوع میکروتیرک را با استفاده از تئوری ارتعاشی غیرخطی در حالت تغییر شکل بزرگ مدلسازی کرده و با استفاده از روش چند مقیاسی^۳ معادله دیفرانسیل حرکت را حل كردند[1۵]. آنها نتايج بدست آمده را با نتايج عملي صحتسنجی کردند. قادری و نجات با استفاده از روش چند مقياسي معادله ديفرانسيل حركت پيزوالكتريك ناپيوسته را در نزدیکی سطح نمونه در حالت غیرتماسی مدلسازی رياضي كردند[١٧].

در کاربری میکروسکوپ نیروی اتمی عملکرد سیستم به حساسیت حرکت ارتعاشی میکروتیرک وابسته است. توپوگرافی دقیق سطح نمونه و نانو ذره و همچنین تعیین خواص دقیق آنها نیز مستلزم داشتن درکی کامل از چگونگی تاثیر هر یک از ضرایب نیروی برهم کنش بر حرکت روش عملی و کارآمد است که به کمک آن میتوان به مطالعه دقیق چگونگی تاثیر هر یک از پارامترها بر حرکت ارتعاشی پرداخت. در بین روشهای تحلیل حساسیت، روش Sobol یکی از بهترین روشها است که میتواند برای مدل-های مونوتونیک^۴ وغیر مونوتونیک مورد استفاده قرار بگیرد.

^tMonotonic

٨۶

این روش در تحلیل حساسیت یافتههای عددی بسیار کارآمد است[۱۸]. تاکنون مطالعاتی بر روی چگونگی تاثیر پارامترهای مختلف بر حرکت ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمى ميكروتيرك به كمك روش تحليل حساسيت انجامشدهاست. تاثیر ابعاد هندسی میکروتیرک پیزوالکتریک بر روی ضریب غیرخطی حرکت ارتعاشی در محيط مايع توسط كورايم و قادرى انجام گرديد[19]. آنها معادله حرکت ارتعاشی را با استفاده از روش چند مقیاسی حل کرده و با تعریف ضریب غیرخطی، میزان غیرخطی بودن حركت ارتعاشى رابه كمك روش تحليل حساسيت مورد مطالعه قرار دادند. موسى پور و همكارانش تحليل حساسیت میکروتیرک مستطیلی میکروسکوپ نیروی اتمی را در حالت خمش-پیچش انجام دادند[۲۰]. آنها تاثیر سختی تماس عمودی و جانبی را بر روی فرکانس تشدید و حساسیت مدها مورد مطالعه قرار دادند. کورایم و همکارانش تاثیر پارامترهای فرایند دستکاری نانو ذرات را بر روی میکروتیرک مستطیلی و V شکل به کمک روش تحلیل حساسیت بررسی کردند[۲۱]. Lee و همکارانش حساسیت خمشی میکروتیرک V شکل را بررسی و با نتایج تئوري كلاسيك مقايسه كردند [۲۲].

از آنجایی که تاکنون مطالعات کاملی بر روی حرکت ارتعاشی غیرخطی میکروتیرک پیزوالکتریک با ناپیوستگی هندسی دربرهمکنش با سطح نمونه و نانو ذرات انجام نشده است، در این مقاله برای اولین به مدلسازی و شبیهسازی چگونگی رفتار ارتعاشی غیرخطی این نوع میکروتیرک در حضور نانو ذره کروی و سطح نمونه پرداخته میشود. با توجه به ناپیوستگیهای هندسی موجود در این نوع میکرو-تیرکها مدل تیر ناپیوسته مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور حل معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت در حوزه زمان روشهای عددی رانگ کوتا و المان محدود و روش چند مقیاسی انتخاب میشود. معادله دیفرانسیل حرکت برای اولین به این سه روش حل شده و نتایج با یکدیگر

°Heaviside

مورد مقایسه قرار می گیرند. از آنجایی که مطالعه علمی و دقیق چگونگی رفتار میکروتیرک در حضور سطح نمونه نانو ذرات نیازمند انجام تحلیل حساسیت است. تحلیل حساسیت مبتنی بر روش Sobol در نزدیکی نانو ذره انجام میشود تا تاثیر ضرایب نیرویی بر حرکت ارتعاشی میکرو-تیرک در هر یک از مدهای نوسانی مشخص شود. با استفاده از این نتایج توپوگرافی سطح نمونه و همچنین نانو ذرات قابل بحث و نتیجه گیری می باشد.

۲- مدلسـازی دینـامیکی حرکــت میکـرو-تیرک پیزوالکتریک

به منظور استخراج معادله دیفرانسیل حرکت ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک از اصل همیلتون استفاده میشود. با توجه به تئوری اویلر-برنولی از اثرات اینرسی دورانی و همچنین تنش برشی صرفنظر میشود. انرژی جنبشی کل سیستم (KE برشی صرفنظر میشود. انرژی جنبشی کل سیستم (KE = $\frac{1}{2} \int_{0}^{L_{1}} (\rho_{1}h_{1}w_{1} + \rho_{2}h_{2}w_{2} + \rho_{2}h_{3}w_{3} + \rho_{4}h_{4}w_{4})\dot{v}^{2}dx$ $+ \frac{1}{2} \int_{L_{1}}^{L_{2}} \rho_{1}h_{1}w_{1}\dot{v}^{2}dx + \frac{1}{2} \int_{L_{2}}^{L} \rho_{1}h_{1}w_{1}\dot{v}^{2}dx$ (۱)

که در این رابطه v تغییر شکل میکروتیر ک و ρ دانسیته هر لایه میباشند. شماره گذاری لایه ها از پایین به بالا انجام شده و ابعاد هندسی با توجه به شکل (۱) مشخص می شود. با استفاده از تابع هیوی ساید 6 رابطه (۱) را می توان به شکل ساده شده بیان کرد.

$$KE = \frac{1}{2} \int_{0}^{L} m(x) \dot{v}^{2} dx$$
 (Y)

که در این رابطه:

$$m(x) = \sum_{i=1}^{4} \rho_{i} h_{i} w_{i} (H_{0} - H_{L_{1}}) + \rho_{1} h_{1} w_{1} (H_{L_{1}} - H_{L_{2}}) + \rho_{1} h_{1} w_{i} (H_{L_{2}} - H_{L})$$
(*)

$$H_{L_i} = H(x - L_i)$$
(*)

سال پانزدهم، شماره ۴۸، بهار ۱۳۹۶

در این رابطه (X) و (X) و (X) بهترتیب سختی و کوپلینگ الکترومکانیکی میباشند و عبارتند از: $K(x) = K_{1}(H_{0} - H_{L_{1}}) + K_{2}(H_{L_{1}} - H_{L_{2}})$ $+ K_{3}(H_{L_{2}} - H_{L})$ (A) $K_{1} = \sum_{k=1}^{4} E_{K}h_{K}w_{K} \Biggl\{ \Biggl[\frac{\sum_{i=1}^{4} E_{i}h_{i}w_{i} \left(\sum_{j=1}^{i}h_{j} - \frac{h_{i}}{2}\right)}{\sum_{i=1}^{4} E_{i}h_{i}w_{i}}$ $- \Biggl(\sum_{j=1}^{k}h_{j} - \frac{h_{k}}{2} \Biggr) \Biggr]^{2} \times \frac{h_{k}^{2}}{12} \Biggr\}; \quad K_{2} = E_{1}\frac{w_{1}h_{1}^{3}}{12};$ (A) $K_{3} = E_{1}\frac{w_{i}h_{1}^{3}}{12}$ $C_{e} = w_{3}d_{31}E_{3}\Biggl[h_{1} + h_{2} + \frac{h_{3}}{2} - \sum_{i=1}^{4} E_{i}h_{i}w_{i}$ $\left(\sum_{i=1}^{i}h_{j} - \frac{h_{i}}{2} \Biggr) / \sum_{i=1}^{4} E_{i}h_{i}w_{i} \Biggr] (H_{0} - H_{L_{1}})$ (Y ·)

با مشخص شدن انرژی جنبشی و پتانسیل میکروتیرک، با استفاده از روش لاگرانژ معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت را با اکتساب میرایی و بار اعمالی به نوک پراب میتوان به این صورت بیان کرد [۱۹].

$$m(x)\frac{\partial^{2}v}{\partial t^{2}} + \frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}} \left[K(x)\frac{\partial^{2}v}{\partial x^{2}} \right] + P(t)\frac{\partial^{2}C_{e}(x)}{\partial x^{2}} + C\frac{\partial v}{\partial t} = f_{y}\delta(x-L) + \frac{\partial}{\partial x} (f_{x}L_{p}\delta(x-L))$$

$$(11)$$

که در این رابطه C ضریب میرایی بوده و با توجه به شکل f_y و f_x ،(۱) و f_y مولفههای نیروی اعمالی به نوک پراب از جانب سطح نمونه یا نانوذره میباشند، این مولفهها برحسب نیروی f عبار تند از:;

$$f_x = f \sin \alpha \ ; f_y = f \cos \alpha \tag{11}$$

C ضریب میرایی میکروتیرک و L_p نیز طول پراب را مشخص می کنند. این مقاله به بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک در برهمکنش با سطح نمونه و همچنین نانوذره می پردازد. به منظور شبیه سازی نیروی برهم کنش، نوک پراب به شکل کره و سطح نمونه نیز بصورت یک سطح صاف درنظر گرفته می شوند. مطالعات نشان می دهد که این هندسه تقریب خوبی برای تخمین نیروی برهمکنش بین نوک پراب و سطح نمونه می باشد [۲۳]. این نیرو در حالت غیر تماسی بصورت نیروی



شکل ۱- شماتیک میکروتیرک پیزوالکتریک [۱۹]

برای محاسبه انرژی پتانسیل میکروتیرک به روابط تنش-کرنش لایهها نیاز است. رابطه اصلی مواد پیزوالکتریک در تغییر شکل جانبی (خمش) عبارت است از:

$$\sigma_{xx}^{p} = E_{3}\varepsilon_{xx}^{p} - E_{3}d_{31}\frac{P(t)}{h_{3}}$$
(Δ)

که در این رابطه σ_{xx}^{p} و σ_{xx}^{p} به ترتیب تنش و کرنش در راستای طولی لایه پیزوالکتریک، d_{31} نابت پیزوالکتریک و P ولتاژ ورودی به لایه پیزوالکتریک میباشند. به این ترتیب انرژی پتانسیل میکروتیرک(PE) را میتوان بصورت رابطهی (۶) نوشت.

$$PE = \frac{1}{2} \int_{0}^{L_{1}} \left(E_{1}I_{1} + E_{2}I_{2} + E_{3}I_{3} \right) \left[\frac{\partial^{2}v}{\partial x^{2}} \right]^{2} dx$$

+ $\frac{1}{2} \int_{0}^{L_{1}} \int_{A} E_{3}d_{31} \frac{P(t)}{h_{3}} \frac{\partial^{2}v}{\partial x^{2}} dAdx$
+ $\frac{1}{2} \int_{L_{1}}^{L_{2}} E_{1}I_{1} \left[\frac{\partial^{2}v}{\partial x^{2}} \right]^{2} dx + \frac{1}{2} \int_{L_{1}}^{L_{2}} E_{1}I_{t} \left[\frac{\partial^{2}v}{\partial x^{2}} \right]^{2} dx$ (5)

که در آن I معرف گشتاور دوم سطح هر لایه میباشد. با استفاده از تابع هیویساید و همچنین با در نظر گرفتن روابط مقاطع چند لایه، رابطهی (۶) را میتوان به شکل ساده شده بیان کرد.

$$PE = \frac{1}{2} \int_0^L K(x) \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right]^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^{L_1} C_e P(t) \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} dx \tag{Y}$$

 $\psi_n(x) =$ $\int A_n^{(1)} Sin \beta_n^{(1)} x + B_n^{(1)} Cos \beta_n^{(1)} x + C_n^{(1)} Sin \beta_n^{(1)} x$ $+ D_{n}^{(1)} Cosh \beta_{n}^{(1)} x,$ $0 \le x \le L_1$ $\int A_n^{(2)} Sin\beta_n^{(2)} x + B_n^{(2)} Cos\beta_n^{(2)} x + C_n^{(2)} Sinh\beta_n^{(2)} x$ $+ D_n^{(2)} Cosh \beta_n^{(2)} x,$ $L_1 \leq x \leq L_2$ $A_n^{(3)}Sin\beta_n^{(3)}x + B_n^{(3)}Cos\beta_n^{(3)}x + C_n^{(3)}Sinh\beta_n^{(3)}x$ $+ D_n^{(3)} Cosh \beta_n^{(3)} x,$ $L_2 \leq x \leq L$ (17)

 $D_n^{(i)}, C_n^{(i)}, B_n^{(i)}, A_n^{(i)}, \beta_n^{(i)} = \sqrt[r]{\frac{\omega_n^r m}{EI}}$ که در آن مقادیر مجهولی هستند که با استفاده از شرایط مرزی تیریک سردر گیر، شرایط پیوستگی و همچنین شرط واحد-سازی نسبت به جرم بدست میآیند. شرایط مرزی:

$$\psi_{1n}(0) = 0, \psi'_{1n} = 0;$$

$$\psi''_{3n}(L) = 0, \psi'''_{3n}(L) = 0;$$

(1A)

$$\begin{split} \psi_{1n}(L_{1}) &= \psi_{2n}(L_{1}), \psi_{1n}'(L_{1}) = \psi_{2n}'(L_{1}); \\ \psi_{2n}(L_{2}) &= \psi_{3n}(L_{2}), \psi_{2n}'(L_{2}) = \psi_{3n}'(L_{2}); \\ K_{1}\psi_{1n}''(L_{1}) &= K_{2}\psi_{2n}''(L_{1}); \\ K_{1}\psi_{1n}'''(L_{1}) &= K_{2}\psi_{2n}'''(L_{1}); \\ K_{2}\psi_{1n}'''(L_{1}) &= K_{3}\psi_{2n}''(L_{1}); \\ K_{2}\psi_{1n}'''(L_{1}) &= K_{3}\psi_{2n}'''(L_{1}) \\ \vdots \\ \end{split}$$
(19)

$$\int_{\cdot}^{L} \psi_{n}^{v}(x) dx = v \qquad (\gamma \cdot)$$

باجایگذاری رابطه (۱۶) در رابطه (۱۱) و با استفاده از روش لاگرانژ معادله دیفرانسیل حرکت را می توان به شکل زیر بیان کرد.

$$\ddot{q}_n + \omega_n^2 q_n + \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} \dot{q}_n = F_n(t) + \gamma_n P(t)$$
که در آن:

$$\omega_n^2 = \int_0^L \psi_n \frac{d^2}{dx^2} \left(K(x) \frac{d^2 \psi_n}{dx^2} \right) dx \tag{(YY)}$$

$$C_{nm} = \int_0^L C \psi_n \psi_m dx \tag{(TT)}$$

جاذبه عمل مىكند كه از انرژى واندروالسى بين دواتم استخراج می شود. برای هندسه کره -سطح صاف نیروی واندروالس عبارت است از:

$$f(d) = \frac{Hr_t}{6d^2} \tag{17}$$

که در این رابطه H ثابتHamaker و r_t شعاع نوک می-باشد. d فاصله یبین نوک پراب تا سطح نمونه را در هر لحظه از زمان مشخص مى كند، كه عبارت است از: $d = d_0 + v(L,t)$ (14)

فاصله تعادلی بین نوک ذره تا سطح نمونه را مشخص d_0 می کند. در صورتی که به جای سطح صاف از نانوذره کروی استفاده شود، نیروی واندروالسی را می توان بصورت زیر بیان کرد[۲۳].

$$f(d) = -\frac{2}{3} \frac{Hr_t r_p}{(d + r_t + r_p)^2 (d - r_t - r_p)^2}$$
(1a)

۲-۱- روش آناليز مودال

در روش برهمنهی مدها عملاً انتقالی از مختصاتهای جابجایی هندسی به مختصاتهای نرمال انجام میشود. برای میکروتیرک شکل(۱) که تنها تغییر شکل جانبی دارد، این انتقال به این صورت بیان میشود.

$$v(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x) q_n(t) \tag{19}$$

 $q_n(t)$ که در آن $\psi_n(x)$ شکل مد n ام میکروتیرک و مختصات عمومی می باشد. با توجه به ناپیوستگیهای میکروتیرک بر اساس مدل تیر ناپیوسته، میتوان میکرو-تیرک را به تیرهای یکنواخت تقسیم کرد. با انجام این تقسیم تیرک شکل (۱) به سه تیر یکنواخت شکل مدها را می توان بصورت زیر نوشت. F^{FEM} پیزوالکتریک میباشد. این ماتریس ها و بردار نیروی عبارتند از:

$$Q = [Q_1(t), ..., Q_n(t), ..., Q_{2n}(t)]^T$$
(⁽¹⁾)

$$M^{FEM} = \sum_{j=1}^{n} \int_{0}^{L} m(x) N_{j}^{T} N_{j} dx \qquad (\Upsilon\Upsilon)$$

$$K^{FEM} = \sum_{j=1}^{n} \int_{0}^{L} EI(x) N_{j}^{T} N_{j} dx \qquad (\Upsilon\Upsilon)$$

$$F^{FEM} = f_x^{FEM} N(L_e)Q(t) + f_y^{FEM} \frac{dN(L_e)}{dx}Q(t)$$
(TF)

که در آن *ز*Nتوابع شکل هرمیتی برای المان تیر بوده و L_e بیا بیانگر طول المان می باشد. ماتریس میرایی در محاسبات بصورت خطی و متناسب با فاکتور کیفیت لحاظ می شود. در فرمولاسیون روش المان محدود نیروی برهم کنش را می توان به این صورت بیان کرد:

- نيروى برهم کنش نوک-سطح نمونه:
$$f^{FEM} = \frac{Hr_r}{r_r}$$

$$f = \frac{1}{6D^2}$$
- نیروی برهمکنش نوک- نانو ذره:

$$f^{FEM} = \frac{-2Hr_{t}r_{p}}{3(D+r_{t}+r_{p})^{2}(D-r_{t}-r_{p})^{2}}$$
(٣۶)

$$D = d + N(L_e)q \tag{(YY)}$$

نیروهای غیرخطی (۳۵) و (۳۶) را میتوان با استفاده از روش Reddy [۲۴] در یک زمان قبل از تغییر شکل انجام شده محاسبه کرد. این روش ساده سازی شده، تکنیکی است که برای مسائل غیر خطی در روش المان محدود مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۳- روش چند مقیاسی

روش چند مقیاسی، روش دیگری برای حل معادله دیفرانسیل حرکت میباشد. برای این منظور ابتدا نیروی برهمکنش بین نوک پراب و سطح نمونه و یا نانو ذره به کمک بسط تیلور، بسط داده شده، سپس با استفاده از رابطه (۱۶) و با بهرهگیری از روش لاگرانژ معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت به این صورت بیان میشود.

$$F_{n} = \int_{0}^{L} \psi_{n} \left\{ f_{y} \delta(x - L) + \frac{d}{dx} \left[f_{x} L_{p} \delta(x - L) \right] \right\} dx$$

$$(\Upsilon \mathfrak{F})$$

$$\gamma_{n} = -\int_{0}^{L} \psi_{n} \frac{d^{2} C_{e}}{dx^{2}} dx$$

$$(\Upsilon \Delta)$$

معادله دیفرانسیل معمولی حرکت (۲۱) را برای
$$k$$
 مدمی-
توان به شکل ماتریسی زیر بیان کرد.
 $M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = F$ (۲۶)
که در آن:

$$\begin{split} K &= \left[\omega_n^2 \delta_{nm} \right]_{k \times k}; \ C &= \left[C_{nm} \right]_{k \times k}; \ M &= I_{k \times k}; \\ q &= \left[q_1(t), q_2(t), \dots, q_n(t) \right]_{k \times l}^T; \\ F &= \left[F_1(t) - P(t) \gamma_1, \dots, F_n(t) - P(t) \gamma_n \right]_{k \times l}^T \end{split}$$
(YY)

$$\dot{Y} = AY + B \tag{(YA)}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & I \\ M^{-1}K & M^{-1}C \end{bmatrix}_{2k \times 2k};$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ M^{-1}F \end{bmatrix}_{2k \times 1}; Y = \begin{bmatrix} q \\ \dot{q} \end{bmatrix}$$
(19)

برای حل معادله (۲۹) می توان از روشهای عددی کمک گرفت. که برای این منظور از روش رانج کوتا در نرمافزار متلب استفاده می شود.

۲-۲- روش المان محدود

روش المان محدود روش دومی است که در این مقاله به کمک آن به حل معادله دیفرانسیل حرکت (۱۱) پرداخته میشود. برای استفاده از تکنیک المان محدود استاندارد، معادلات دیفرانسیل معمولی حرکت میکروتیرک را میتوان معادلات دیفرانسیل معمولی حرکت میکروتیرک میتادارد، بصورت زیر بیان کرد. $M^{FEM} \overset{Q}{Q} + C^{FEM} \overset{Q}{Q} + K^{FEM} Q = F^{FEM} (Q)$ (۳۰) که در آن $M^{FEM} \overset{M^{FEM}}{M}$ و M^{FEM} میز بردار جرمی، سختی و میرایی کلیتیرک هستند. 2 نیز بردار جابجایی کلی تیرک است. F^{FEM} نیز بردار نیروی خطی است که شامل نیروی برهمکنش و ولتاژ تحریک لایه

$$P(\tau_0) = \frac{1}{2} P e^{\Omega \tau_0} + cc$$
 (۴۸)
در این رابطه Ω فرکانس تحریک لایه پیزوالکتریک میباشد.
از آنجایی که در کاربری میکروسکوپ نیروی اتمی، میکرو-
تیرک باید با فرکانس طبیعی و یا در نزدیکی آن تحریک

شود، بنابراین فرکانس تحریک را میتوان به این صورت بیان کرد: $\Omega = \Omega_n + \sigma \varepsilon^2$ (۴۹) که در آن σ پارامتر انحراف فرکانس تحریک از فرکانس

طبیعی میباشد. با جایگذاری روابط (۴۷) تا (۴۹) در معادلات دیفرانسیل (۴۵) و (۴۶) و حل این معادلات رابطه-ی (۵۰) بدست میآید.

$$\frac{10\xi_1^2 + 9\Omega_n^2\xi_2}{\Omega_n^3} B_n^2 B_n^* - i\mu_n B_n - \frac{\gamma_n P}{2\Omega_n} e^{-i\sigma\tau_2}$$

$$-2iD_2 B_n = 0$$
($\Delta \cdot$)

در این رابطه B_n^* معرف مزدوج مختلط است. برای حل معادله (۵۰) بهتر است که B_n به شکل قطبی بیان شود.

$$B_n = \frac{1}{2} b_n e^{i\beta_n} \tag{(\Delta1)}$$

که در آن b_n و β_n بهترتیب مقادیر حقیقی دامنه و فاز حرکت میباشند. با جایگذاری رابطه (۵۰) در رابطه (۵۱) و جداسازی ضرایب حقیقی و موهومی معادلهی (۵۲) برای دامنه و فاز حرکت بدست میآیند.

$$\begin{cases} \frac{10\xi_1^2 + 9\Omega_n^2\xi_2}{8\Omega_n^3}b_n^3 + \sigma b_n - \frac{\gamma_n P}{2\Omega_n}\cos\theta_n - b_n\dot{\theta}_n = 0\\ 2\dot{b}_n - \frac{\gamma_n P}{\Omega_n}\sin\theta_n + \mu_n b_n = 0 \end{cases}$$
 (57)

در این رابطه $\sigma \tau_2 - \beta_n = \sigma \tau_2 - \beta_n$ است. از آنجایی که در این تحلیل پاسخ حالت ماندگار حرکت ارتعاشی مدنظر میباشد، بنابراین مقادیر \dot{b}_n و \dot{b}_n برابر صفر درنظر گرفته میشود. با حذفn از رابطه (۵۲)، معادله غیرخطی پاسخ فرکانسی بدست میآید.

$$\left(\frac{1}{2}\mu_{n}b_{n}\right)^{2} + \left(\sigma b_{n} + \frac{10\xi_{1}^{2} + 9\Omega_{n}^{2}\xi_{2}}{8\Omega_{n}^{3}}b_{n}^{3}\right)^{2}$$
$$= \left(\frac{1}{2\Omega_{n}}P\gamma_{n}\right)^{2} \qquad (\Delta\Upsilon)$$

$$\ddot{q}_n + \Omega_n^2 q_n + \mu_n \dot{q}_n - \xi_1 q_n^2 - \xi_2 q_n^3 + \gamma_n P(t) = 0$$
(۳۸)

که در آن:

$$\Omega_n^2 = \int_0^L \psi_n \left\{ \frac{d^2}{dx^2} \left(K(x) \frac{d^2 \psi_n}{dx^2} \right) - f(d_0) \psi_n \cos \alpha \delta(x - L) \right\}$$
(٣٩)

$$\xi_1 = \int_0^L 0.5 \psi_n^3 f'(d_0) \cos\alpha \delta(x-L) dx \qquad (\pounds \cdot)$$

$$\xi_{2} = \int_{0}^{L} -\frac{1}{6} \psi_{n}^{3} f''(d_{0}) \cos \alpha \delta(x-L) dx$$
 (F1)

که در آنµ میرایی مودال میباشد. به منظور حل معادله دیفرانسیل (۳۸) به روش چند مقیاسی میتوان متغیرqn را به اینصورت تعریف کرد.

$$q_{n}(t) = \varepsilon q_{n1}(\tau_{0}, \tau_{1}, \tau_{2}) + \varepsilon^{2} q_{n2}(\tau_{0}, \tau_{1}, \tau_{2}) + \varepsilon^{3} q_{n3}(\tau_{0}, \tau_{1}, \tau_{2}) + o(\varepsilon^{4})$$
(fr)

که در آن $\tau_n = \varepsilon^n t$ میباشد. ε نیز معرف پارامتر تغییرات در روش چند مقیاسی میباشد. با استفاده از روش چند مقیاسی مشتقات زمانی را می توان به این صورت بیان کرد. $\frac{d}{dt} = D_0 + \varepsilon D_1 + \varepsilon^2 D_2 + o(\varepsilon^3)$ (۴۳)

$$O(\varepsilon): D_0^2 q_{n1} + \Omega_n^2 q_{n1} = 0 \tag{(ff)}$$

$$O(\varepsilon^{2}): D_{0}^{2}q_{n2} + \Omega_{n}^{2}q_{n2} + 2D_{0}D_{1}q_{n1} - \xi_{1}q_{n1}^{2} = 0$$
 (fa)

$$O(\varepsilon^{3}): D_{0}^{2}q_{n3} + \Omega_{n}^{2}q_{n3} + 2D_{0}D_{1}q_{n2} + 2D_{0}D_{2}q_{n1} + \mu_{n}D_{0}q_{n1} + D_{1}^{2}q_{n1} + \gamma_{n}P - 2\xi_{1}q_{n1}q_{n2} - \xi_{2}q_{n1}^{3} = 0$$
(FF)

$$q_{n1} = B_n(T_1, T_2)e^{i\Omega_n\tau_0} + cc \tag{Ψ}$$

که در آن *B*_n دامنه مختلط و *cc* بیانگر مزدوج مختلط می-باشد. ولتاژ تحریک لایه پیزوالکتریک که باعث ارتعاش میکروتیرک میشود را میتوان چنین بیان کرد:



شکل ۲-دامنه و فرکانس تشدید میکروتیرک پیزوالکتریک در سه مد اول نوسانی

Wolf و Gottlieb میکروتیر ک پیزوالکتریک را با لایه پیزو سراسری در حالت یکنواخت مورد بررسی قرار دادند [۱۳]. آنها با در نظر گرفتن نیروی بین نوک و نمونه در شرایط مرزی معادله دیفرانسیل حرکت، فرمول بندی دیگری را برای پاسخ فرکانسی ارائه دادند. به منظور مقایسه حل انجام شده در این مقاله با روش Wolf و Gottlieb فرض میشود که لایه پیزوالکتریک واقع بر روی میکروتیرک از جنس Ho-TZT بوده، تمام سطح آن را پوشش داده و میکرو-تیرک بصورت یکنواخت باشد. شکل (۳) پاسخ فرکانسی میکروتیرک را در دو فاصله تعادلی ۱ و ۲ نانومتر نشان می-دهد. مقایسه نتایج تطابق بسیار خوبی را بین روش حل بکار گرفته شده توسط Molf و Gottlieb و روش حل چند مقیاسی این مقاله نشان میدهد.

با نزدیک شدن میکروتیرک به سطح نمونه و نانو ذره نیروی برهم کنش شدت گرفته و باتوجه به غیرخطی بودن این نیرو رفتار ارتعاشی میکروتیرک نیز غیرخطی خواهد شد. شکل (۴) چگونگی تغییرات دامنه حرکت نوک میکروتیرک را با نزدیک شدن به سطح نمونه نشان میدهد. در این شکل برای محاسبه دامنه حرکت ارتعاش غیرخطی میکروتیرک به منظور مطالعه رفتار ارتعاشي ميكروتيرك پيزوالكتريك درنزدیکی سطحنمونه ونانوذره ازDMASP میکروتیرک ساخت شركت Bruker استفاده مى شود. اين ميكروتيرك ازجنس سیلیکون بوده که یک لایه پیزوالکتریک ZnO مطابق شکل (۱) برروی آن قرار گرفته است. این لایه توسط دوالكترود Au بهصورت كامل محصورمى شود. مشخصات هندسی وهمچنین خواص مکانیکی هریک ازلایههای این میکروتیرک بهترتیب درجداول (۱) و (۲) آورده شدهاند. بهمنظور بررسی توانایی روشهای تیر ناپیوسته و المان محدود درمحاسبه فركانسهاى طبيعى ودامنه تشديد ميكروتيرك پيزوالكتريك ناپيوسته، درابتدا نتايج ايندو مدل با نتایج عملی [۱۶] مقایسه می شود. در شکل (۲) این مقایسه بین سه مد اول نوسانی میکروتیرک انجام شده است. همانطور که مشاهده می شود هردو مدل انتخاب شده ازدقت خوبى درمحاسبه فركانسهاي طبيعي ودامنه تشديد این نوع میکروتیرک برخوردارمیباشند، که دراین بین روش المان محدود ازدقت كمى بهترنسبت به مدل تيرناپيوسته برخوردار است.

جدول ۱- مشخصات هندسی میکروتیرک شبیهسازی

شده[۱۵]					
h (μm)	W (μm)	L (μm)	جنس		
٣/٠	۲۵۰	۳۵۰	Si	لايه پايه	
۳/۴	۱۳۰	۳۳۰	ZnO	لايه پيزو	
٠/٢	۱۳۰	۳۳.	Au	الكترودها	
٣/٠	۵۵	187	Si	نوک	

جدول ۲- مشخصات جنس میکروتیرک شبیهسازی شده[۱۵]

d ₂₁ (pC/N)	ρ (kg/m ³)	E (Gpa)	
-	۲۳۳۰	۱۸۰	لايه پايه
11	۶۳۹ <i>۰</i>	1.4	لايه پيزو
-	19800	٧٨	الكترودها
-	۲۳۳۰	۱۸۰	نوک

٩٢

از روش حل تحلیلی چندمقیاسی، حل عددی رانج کوتا و همچنین روش المان محدود استفاده شده است. برای استخراج نتایج این شکل، ابتدا میکروتیرک با دامنه تشدید مد اول در فاصلهای دور از سطح نمونه تحریک شده سپس فاصله آن ازسطح نمونه کاهش پیدا میکند. با کم شدن فاصله میکروتیرک تا سطح نمونه نیروی برهمکنش شدت گرفته و با توجه به ماهیت غیرخطی این نیرو، نه تنها دامنه حرکت بلکه فرکانس تشدید نیز تغییر میکند. به این ترتیب با نزدیک شدن میکروتیرک به سطح نمونه و شدت گرفتن مقدار غیرخطی بودن نیرو اختلاف فرکانس تحریک و فرکانس تشدید بیشتر شده و در نتیجه دامنه حرکت ارتعاشی کاهش پیدا میکند. شدت گرفتن اندازه نیروی برهمکنش با کم شدن فاصله دلیل دیگر این کاهش دامنه میباشد.







نمونه

با توجه به شکل (۴) کاهش دامنه در نتایج هر سه مدل دیده میشود. همانطور که مشاهده میشود، نتایج بدست آمده از سه مدل نزدیک به یکدیگر بوده با این تفاوت که با کم شدن فاصله تعادلی نتایج روش تحلیلی از دو روش عددی بکار رفته شده فاصله میگیرد. همانطور که قبلا نیز بیان شد با کم شدن فاصله میگیرد. همانطور که قبلا نیز نیرو شدت میگیرد، ازآنجایی که روش چند مقیاسی برای مسائل غیرخطی ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد، بنابراین دقت روش با کمشدن فاصله تعادلی کاهش مییابد و اختلاف نتایج آن از دو مدل عددی به کار رفته شده بیشترمیشود. در جدول (۳) نیز نتایج مدلسازی دامنه حرکت ارتعاشی میکروتیرک در نزدیکی نانو ذره به کمک سه مدل محاسباتی انتخاب شده آورده شده است. نزدیک بودن نتایج سه مدل انتخابی را در اعداد این جدول نیز میتوان مشاهده کرد.

جدول ۳- مقایسه دامنه میکروتیرک در نزدیکی نانو ذره در روشهای محاسباتی انتخاب شده

v (L) (nm)			
رانج كوتا	المان محدود	چند مقیاسی	<i>r</i> _p (nm)
٧/٧٠٢	۷/۸۰۲	٧/٩١٧	۳۰
V/587	٧/۶۶۴	$V/VV\Delta$	١٠٠
٧/۴٧١	۷/۵۶۶	٧/۶٨٢	۳۰۰
٧/٣٣٢	V/47V	٧/۵۴١	۵۰۰

در حرکتهای ارتعاشی خطی زمانی که میکروتیرک با فرکانس تشدید تحریک شود، پاسخ مدهای ارتعاشی دیگر تاثیر بسیار اندکی در تغییر شکل دارند. اما در حرکت ارتعاشی غیرخطی تاثیر مدهای دیگر بر تغییر شکل قابل توجه میباشد. بنابراین لازم است که تغییر شکل میکرو-تیرک با لحاظ مدهای نوسانی بالاتر محاسبه شده تا بتوان به جواب دقیقتری دست پیداکرد. از آنجایی که در حرکت ارتعاشی میکروتیرک نزدیک نانوذره و سطح نمونه، نیروی غیرخطی میکند، بنابراین لازم است که تاثیر مدهای نوسانی بالاتر نیز بر این حرکت ارتعاشی غیرخطی مورد

بررسی قرارگیرد.شکل (۵) تاثیر مدهای نوسانی مختلف را بر دامنه حرکت تشدید اول میکروتیرک نشان میدهد. در این شکل Δv معرف تغییرات دامنه محاسبه شده با دو مد یا بیشتر نسبت به حالتی که تنها یک مد نوسانی در محاسبات لحاظ شود، مىباشد. با كم شدن فاصله تعادلى پراب تا نانوذره و سطح نمونه و در نتیجه شدت گرفتن نیروی برهمکنش، تاثیر این نیروی غیرخطی بر حرکت ارتعاشی افزایش پیدا میکند.همانطور که در نتایج شکل (۵) نیز مشاهده می شود، در فواصل تعادلی زیاد که شدت غیرخطی بودن سیستم کم است، تاثیر مدهای بالاتر بر حرکت ارتعاشی کم بوده و با کم شدن فاصله تعادلی و افزایش شدت غیرخطی بودن تاثیر مدهای بالاتر بر حرکت ارتعاشي افزايش مي يابد. با توجه به نتايج بدست آمده مي-توان نتیجه گرفت که در این شبیهسازی انتخاب پنج مد نوسانی برای محاسبه دامنه حرکت از دقت خوبی برخوردار است. این مساله در تمامی شبیهسازیهای انجام شده در این مقاله لحاظ می گردد.

منحنی پاسخ فرکانسی میکروتیرک در نزدیکی نانو ذره در شکل (۶) نشان داده شده است. این منحنی از دو شاخه و $^{ ext{-}} ext{FR}$ و $^{ ext{-}} ext{FR}$ تشکیل شده است که این دو شاخه در نزدیکی $ext{FR}^+$ فرکانس تشدید غیرخطی به یکدیگر نزدیک می شوند. با توجه به ناپایداری شاخه FR^+ با اندکی کاهش فرکانس تحریک، پرش تندی از شاخه FR^+ به FR^- اتفاق می افتد. که به همراه آن دامنه حرکت به شدت افت پیدا میکند. نتایج شبیهسازی نشان میدهند که شدت پرش در پاسخ فرکانسی در مدهای نوسانی بالاتر افت پیدا میکند و یا به عبارت دیگر ناپایداری حل در مدهای نوسانی بالا کمتر می-شود. و به این ترتیب کاهش دامنه ناشی از ناپایداری افت پیدا می کند. از آنجایی که نیروی جاذبه واندروالسی بین نوک پراب و نانو ذره نیرویی غیرخطی است، بنابراین با نزدیک شدن پراب به نانو ذره نه تنها دامنه کاهش پیدا می کند، بلکه فرکانس تشدید نیز از مقدار خطی خود فاصله می گیرد. این تغییر فرکانسی که با توجه به شکل (۶) بصورت افت فركانسى قابل مشاهده است، با افزايش شعاع

نانو ذره و در نتیجه شدت گرفتن نیروی برهم کنش بیشتر می شود. این موضوع در هر سه مد نوسانی اول که مورد شبیه سازی قرار گرفته است، دیده می شود.



شکل ۵- تاثیر مدهای نوسانی بالا بر دامنه تشدید مد اول میکروتیر ک

به منظور تعیین چگونگی تاثیر هریک از ضرایب نیروی برهمکنش نوک- نانو ذره بر حرکت ارتعاشی میتوان از روش تحليل حساسيت استفاده كرد. تحليل حساسيت به روش Sobol نه تنها چگونگی تغییرات پارامترهای حرکت ارتعاشی (دامنه و فرکانس تشدید) به ازای مقادیر مختلف ضرایب نیروی برهم کنش را تعیین می کند، بلکه میزان حساسیت دامنه و فرکانس تشدید را به تغییرات هر یک از این ضرایب نیز مشخص می کند. روش Sobol به شبیه-سازی ورودیها بر مبنای توزیع احتمالی با استفاده از روش آنالیز واریانس می پردازد. با استفاده از آنالیز واریانس می-توان اثر متقابل بین چندین ورودی را برروی خروجیها شناسایی کرد. سپس حساسیت خروجی مدل به ازای یک یا چندین ورودی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در روش Sobol ابتدا پارامترهای ورودی انتخاب شده، بازه تغییرات آنها مشخص می گردد. پارامترها به دستههای آماری تقسیم شده و در هر بار تحلیل یک دسته آماری مورد استفاده قرار می گیرد. هر دسته آماری باید شامل تمامی پارامترهای ورودی باشد. دستههای آماری در هر نوبت به عنوان ورودی به مساله ارتعاشی داده شده و به کمک آنها خروجیها که در اینجا فرکانس تشدید و دامنه آن می باشند، محاسبه می-شود. نهایتاً، با توجه به مدل Sobol درصد حساسیت

خروجیها به هر یک از پارامترهای ورودی مشخص می-گردد.



شکل ۶- پاسخ فرکانسی سه مد ارتعاشی اول میکروتیرک در نزدیکی نانو ذره

شکل (۷) چگونگی تغییرات دامنه تشدید سه مد اول را برحسب ضرایب نیرویی نشان میدهد. با توجه به نتایج این شکل میتوان دریافت که حساسیت دامنه تشدید در مد-های نوسانی بالاتر به تغییرات ضرایب نیرویی کاهش پیدا می کند. در واقع حساسیت دامنه تشدید در مدهای نوسانی بالاتر به فاصله تعادلی،اندازه نانوذره و همچنین جنس نانوذره کم میشود. از آنجایی که این کاهش حساسیت در توپوگرافی نانوذره در مد دامنه مطلوب نمیباشد،میتوان

نتیجه گرفت که توپوگرافی نانوذره به کمک این نوع میکرو-تیرک در مداول نوسانی در برگیرنده نتایج دقیق تری می-باشد.



شکل ۷- تاثیر ضرایب نیروی بر دامنه تشدید



شکل (۸) نیز نتایج تحلیل حساسیت فرکانس تشدید سه مد اول میکروتیرک را در مواجهه با نانو ذره نشان میدهد. همانطور که در نتایج این شکل نیز مشاهده میشود، در مدهای نوسانی بالاتر حساسیت فرکانس تشدید به تغییرات ضرایب نیرویی کاهش پیدا میکند. در صورتی که مدکاری میکروسکوپ نیروی اتمی مد فرکانسی انتخاب شود، توپوگرافی نانو ذره و تعیین خواص مکانیکی آن در این حالت نیز در مد اول نوسانی دربرگیرنده نتایج دقیق تری میباشد، چرا که عملکرد سیستم کنترلی در این حالت میباشد، چرا که عملکرد سیستم کنترلی در این حالت فرکانس تشدید به تغییرات پارامترهای نیرویی حساس تر باشد، نتایج بدست آمده نیز از دقت بالاتری برخوردار می-

چنانچه قبلاً نیز اشاره گردید، تحلیل حساسیت نه تنها چگونگی تغیییرات دامنه و فرکانس تشدید اول را نسبت به ضرايب نيرويي مشخص مي كند، بلكه ميزان حساسيت اين پارامترها را به هر يک از ضرايب نيرويي نيز تعيين ميکند. شکل (۹) درصد حساسیت دامنه و فرکانس تشدید را به هریک از ضرایب نیرویی نشان میدهد. همانطور که مشاهده می شود، دامنه و فرکانس تشدید به فاصله تعادلی حساس بوده ولي نسبت به تغييرات شعاع نوك و شعاع نانو ذره از حساسیت کمتری برخوردار میباشند. با توجه نتایج بدست آمده مشخص است که حساسیت دامنه حرکت به تغییرات شعاع نانوذره نسبت به فركانس تشديد بيشتر است. همچنین حساسیت فرکانس طبیعی به تغییرات ثابت همکر از دامنه تشدید بیشتر میباشد. بنابراین در صورتی که هدف از توپوگرافی تعیین شعاع نانوذره باشد، مد دامنه نتایج دقيق ترى نسبت به مد فركانس به همراه خواهد داشت. ولى اگر هدف از توپوگرافی تعیین جنس نانو ذره باشد، مدفر کانسی نتایج دقیقتری را به همراه دارد.



نيرويى

۴- نتیجهگیری

میکروتیر کهای پیزوالکتریک نسل جدیدی از میکروتیر ک-های مورد استفاده در میکروسکوپ نیروی اتمی هستند که با توجه به قابلیتهای بالای آنها مورد توجه قرار گرفتهاند. استخراج نتایج دقیقتر از این نوع تیرکها در توپوگرافی سطح و نانو ذره مستلزم تحلیل و مطالعه چگونگی رفتار ارتعاشی آنها میباشد. با توجه به غیرخطی بودن نیروی برهم کنش، رفتار ارتعاشی میکروتیرک نیز غیرخطی می-باشد. با اکتساب ارتعاشی غیرخطی و همچنین با توجه به ناپیوستگیهای هندسی میکروتیرک، از مدل تیر ناپیوسته و روشهای حل عددی (رانج کوتا و المان محدود) و تحلیلی (چند مقیاسی) استفاده گردید. مقایسه مدل تیر غیر-یکنواخت و روش المان محدود با نتایج عملی نشان می دهد که هر دو روش انتخاب شده از دقت قابل قبولی در مدلسازی حرکت ارتعاشی این نوع میکروتیرک برخوردار مىباشند. با مقايسه نتايج بدست آمده همچنين مىتوان دریافت که مدل المان محدود از دقت بالاتری در تحلیل این نوع تیرک برخوردار است. بیشترین اختلاف روش المان

محدود با نتایج عملی در محاسبه فرکانس سه مد اول نوسانی، ۲/۵ درصد (در مد سوم) و در محاسبه دامنه تشدید ۷/۱ درصد (در مد اول) میباشد. این در حالی است کهدر مدل غیریکنواخت حداکثر اختلاف با روش عملی ۲/۷ و ۸/۶ درصد بهترتیب در محاسبه فرکانس (در مد سوم) و دامنه تشدید (در مد اول) بوده است.

نتایج شبیه سازی نشان میدهند که با نزدیک شدن میکرو-تیرک به سطح نمونه و شدت گرفتن مقدار غیرخطی شدن حرکت، اختلاف روشهای حل رانج کوتا و المان محدود در محاسبه دامنه نوسانی افزایش چندانی نمییابد ولی نتایج روش چند مقیاسی از دو روش عددی دیگر فاصله میگیرد که دلیل این موضوع توانایی کم روش چند مقیاسی در حرکتهای ارتعاشی شدید میباشد.

به منظور مطالعه چگونگی تاثیر هریک از ضرایب نیرویی نوک- نانو ذره و نوک- سطح نمونه برروی پارامترهای حرکت ارتعاشی (فرکانس و دامنه تشدید) تحلیل حساسیت به کمک روش Sobol انجام گرفت. از آنجایی که دقت توپوگرافی سطح نمونه و نانو ذره و همچنین تعیین خواص به میزان حساسیت میکروتیرک به نیروی برهمکنش بستگی دارد، با توجه به نتایج تحلیل حساسیت میتوان دریافت که مد اول نوسانی بهترین مد جهت انجام توپوگرافی میباشد. دلیل این موضوع کاهش حساسیت میکروتیرک به فرایب نیرویی در مدهای نوسانی بالا می-اگر هدف از توپوگرافی تعیین شعاع نانو ذره باشد، مد دامنه نتایج بهتری را به همراه دارد و اگر هدف از توپوگرافی تعیین خواص باشد، مد فرکانسی مناسبتر می باشد.

۱۰- مراجع

 Rebaud, S., Maniti, O., Girard-Egrot, A.P. (2014). "Tethered bilayer lipid membranes (tBLMs): Interest and applications for biological membrane investigations", Biochimie, Vol. 107, pp. 135-142.

- [2] Vigneswaran, N., Samsuri, F., Ranganathan, B. (2014). "Recent Advances in Nano Patterning and Nano Imprint Lithography for Biological Applications", Procedia Engineering, Vol. 97, pp. 1387-1398.
- [3] Muthukumar, T., Prabhavathi, S., Chamundeeswari, M., Sastry T.P. (2014). "Bio-modified carbon nanoparticles loaded with methotrexate possible carrier for anticancer drug delivery", Materials Science and Engineering: C, Vol. 36(1), pp. 14-19.
- [4] Moradi, Z., Atta, M.M., (2014). "An investigation on the inhibitory action of benzazole derivatives as a consequence of sulfur atom induction", Applied Surface Science, Vol. 37, pp. 657-665.
- [5] Grayeli-Korpi, A-R., Savaloni, H., Habibi, M., (2013). "Corrosion inhibition of stainless steel type AISI 304 by Mn coating and subsequent annealing with flow of nitrogen at different temperatures", Applied Surface Science, Vol. 276(1), pp. 269-275.
- [6] Shokrieh, M.M., Hosseinkhani, M.R., Naimi-Jamal, M.R. Tourani, H., (2013). "Nanoindentation and nanoscratch investigations on graphene-based nanocomposites", Polymer Testing, Vol. 32(1), pp. 45-51.
- [7] Moosapour, M., Hajabasi, M.A., Ehteshami, H., (2014). "Thermoelastic damping effect analysis in micro flexural resonator of atomic force microscopy", Applied Mathematical Modelling, Vol. 38 (11-12), pp. 2716-2733.
- [8] Kangarlou, H., Aghgonbad M.M., (2014)Incidence angle dependence on structural and optical properties of UHV deposited copper nano layers", International Journal for Light and Electron Optics, Vol. 125(19), pp. 5532-5537.
- [9] Beigi, M.H., Berenjian, J., Omran, O.L., Sadeghi Nik, A., Nikbin I.M., (2013). "An experimental survey on combined effects of fibers and nanosilica on the mechanical, rheological, and durability properties of self-compacting concrete", Materials & Design, Vol. 50, pp. 1019-1029.
- [10] Jalili, N., Laxminarayana, K., (2004). "A Review of Atomic Force Microscopy Imaging Systems: Application to Molecular Metrology and Biological Sciences". Mechatronic, Vol. 14, pp. 907-945.
- [11] Riel, M.C.J.M., Bos, E.J.C., Homburg, F.G.A., (2014). "Analysis of the measurement sensitivity of multidimensional vibrating microprobes", Measurement Science and Technology, Vol. 25(7), article id. 075008.
- [12] Delnavaz, A., Mahmoodi, S.N., Jalili, N., Zohoor, H. (2010). "Linear and Non-Linear Vibration and Frequency Response Analyses of Microcantilevers Subjected to Tip–Sample Interaction". International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 45, 176-185.
- [13] Wolf, K., Gottlieb, O. (2002). "Nonlinear Dynamics of a Noncontacting Atomic Force Microscope Cantilever Actuated by a Piezoelectric Layer". Journal of Applied Physics, Vol. 91(7), pp. 4701–4709.
- [14] Fung, R.F. Huang, S.C. (2001). "Dynamic Modeling and Vibration Analysis of the Atomic Force Microscope". ASME Journal of Vibration and Acoustics, Vol. 123, pp. 502–509.
- [15] Mahmoodi, S.N., Jalili, N., Ahmadian, M. (2010). "Subharmonics analysis of nonlinear flexural vibrations of piezoelectrically actuated microcantilevers". Nonlinear Dynamics, Vol. 59, pp. 397–409
- [16] Salehi-Khojin, A., Bashash, S., Jalili, N.(2008). "Modeling and Experimental VibrationAnalysis of Nanomechanical CantileverActive Probes". Micromechanics and Microengineering. Vol. 18, 085008 (11pp)
- [17] Ghaderi, R., Nejat, A. (2014). "Nonlinear Mathematical Modeling of Vibrating Motion of Nanomechanical Cantilever Active Probe". Latin American Journal of Solids and Structures. Vol. 11, pp. 369-385.
- [18] Saltelli, K., Chan, E., Scott, E.M. (2000). "Sensitivity Analysis". Wiley, New York.
- [19] Korayem H., Ghaderi R. (2014). "Sensitivity Analysis of Nonlinear Vibration of AFM Piezoelectric Microcantilever in Liquid", International Journal of Mechanics and Materials in Design. Vol. 10(2), pp. 121–131.
- [20] Moosapour, M., Hajabasi, M.A., Ehteshami, H. (2012). "Frequency and Sensitivity Analysis of Atomic Force Microscope (AFM) Cantilever Considering Coupled Flexural–Torsional Vibrations". Digest Journal of Nanotechnology and Biotechnology Vol. 7(3), pp. 1103–1115.
- [21] Korayem, M.H., Zakeri, M., Aslzaeem, M.M. (2011). "Sensitivity Analysis of the Nanoparticles on Substrates Using the Atomic Force Microscope with Rectangular and V-shaped Cantilevers". Micro and Nano Letters, Vol. 6(8), pp. 586–591.
- [22] Lee, H.W., Chang, W.J. (2011). "Sensitivity of V-shaped Atomic ForceMicroscope Cantilevers Based on a Modified Couple StressTheory". Microelectronics Engineering, Vol. 88(11), pp. 3214–3218.
- [23] Sitti, M. (2000)."Controlled Pushing of Nanoparticles: Modeling and Experiments". IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol. 5, pp. 199–211.
- [24] Reddy, J.N.(1993)."An Introduction to the Finite Element Method". McGraw-Hill, New York.